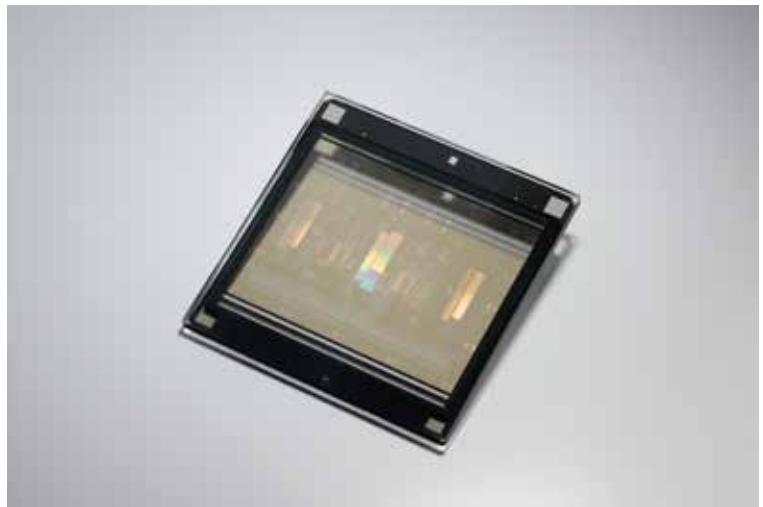


## 光掩模

光掩模是用于 LSI 等集成电路制造工序的重要器件。在透明玻璃板表面的遮光膜上蚀刻加工了非常微细的电路图案，成为对硅晶圆复刻电路时的原版。

### 光掩模的供货业绩实例

- 半导体器件用途
- 光导波路、光学装置用途
- MEMS用途
- LED用途
- 微透镜用途
- 设备精度控制用途
- 校准器用途
- 光刻机用途
- 光致抗蚀剂评价用途
- 分辨率评价用途 等



### 数据格式

- MEBES
- JEOL
- MIC
- VSB
- Gerber
- GDS
- DXF
- DWG
- BMP

※ 欢迎洽询上述以外的格式。

### 可用尺寸

底板尺寸	厚度	材质	遮光膜材质	遮光膜厚度	可绘图区域
152 × 152 mm (6 × 6 英寸)	6.35mm (0.25英寸)	Qz	Cr	105nm	146 × 146mm
		Qz	Cr	73nm	146 × 146mm
		Qz	MoSi (KrF-PSM)	(透过率6%@KrF)	146 × 146mm
		Qz	MoSi (ArF-PSM)	(透过率6%@ArF)	146 × 146mm
	3.05mm (0.12英寸)	Qz	Cr	105nm	146 × 146mm
	2.30mm (0.09英寸)	Qz	Cr	105nm	146 × 146mm
127 × 127mm (5 × 5 英寸)	4.60mm (0.18英寸)	Qz	Cr	105nm	120 × 120mm
	2.30mm (0.09英寸)	Qz	Cr	105nm	120 × 120mm

## 光掩模标准规格

### 激光绘图

项目	规格
	Qz材料
尺寸精度	设计值 $\pm 0.025\mu\text{m}$
总间距精度	设计值 $\pm 0.070\mu\text{m}$
定位精度	设计值 $\pm 0.035\mu\text{m}$
图案缺陷	0.15 $\mu\text{m}$ 0个
最小尺寸	Line图案 0.7 $\mu\text{m}$ , Hole图案 1.0 $\mu\text{m}$

### 50kv电子束绘图

项目	规格
	Qz材料
尺寸精度	设计值 $\pm 0.015\mu\text{m}$
总间距精度	设计值 $\pm 0.050\mu\text{m}$
定位精度	设计值 $\pm 0.025\mu\text{m}$
图案缺陷	0.10 $\mu\text{m}$ 0个
最小尺寸	Line图案 0.4 $\mu\text{m}$ , Hole图案 0.6 $\mu\text{m}$

※ 欢迎洽询上述以外的格式。